

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

25.6.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2004年 4月 6日

出願番号 Application Number: 特願2004-112511

[ST. 10/C]: [JP2004-112511]

REC'D 15 JUL 2004

WIPO PCT

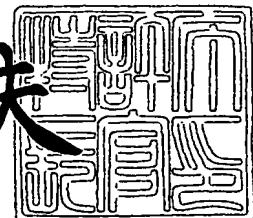
出願人 Applicant(s): 東京応化工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 6月10日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 J16518B1
【提出日】 平成16年 4月 6日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 G03F 7/075 511
【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社
内
【氏名】 田村 弘毅
【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社
内
【氏名】 川名 大助
【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社
内
【氏名】 山田 知孝
【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社
内
【氏名】 細野 隆之
【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社
内
【氏名】 平山 拓
【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社
内
【氏名】 佐藤 和史
【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社
内
【氏名】 新堀 博
【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社
内
【氏名】 安藤 友之
【特許出願人】
【識別番号】 000220239
【氏名又は名称】 東京応化工業株式会社
【代理人】
【識別番号】 100106909
【弁理士】
【氏名又は名称】 棚井 澄雄
【代理人】
【識別番号】 100064908
【弁理士】
【氏名又は名称】 志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】 100101465

【弁理士】

【氏名又は名称】 青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】 100094400

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 三義

【選任した代理人】

【識別番号】 100106057

【弁理士】

【氏名又は名称】 柳井 則子

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2003-166391

【出願日】 平成15年 6月11日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008707

【納付金額】 16,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

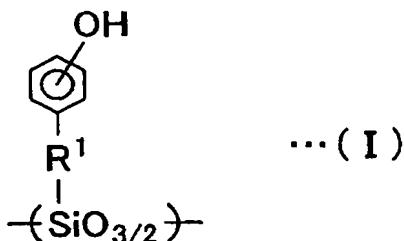
【包括委任状番号】 0117103

【書類名】特許請求の範囲

【請求項 1】

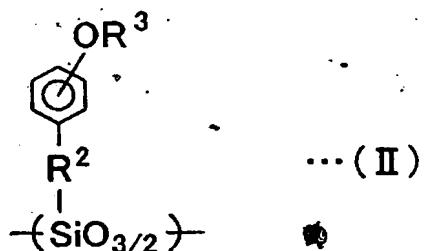
酸の作用によりアルカリ可溶性が増大する樹脂成分（A）と、露光により酸を発生する酸発生剤成分（B）とを含むポジ型レジスト組成物であって、前記（A）成分が、（a 1）下記一般式（I）で表される構成単位、（a 2）下記一般式（I I）で表される構成単位、および（a 3）下記一般式（I I I）で表される構成単位を有するシリセスキオキサン樹脂（A 1）を含有してなることを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【化1】



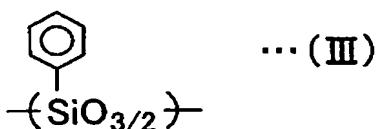
(式中、R¹は炭素数1～5の直鎖状または分岐状のアルキレン基を表す。)

【化2】



(式中、R²は炭素数1～5の直鎖状または分岐状のアルキレン基を表し、R³は酸解離性溶解抑制基を表す。)

【化3】



【請求項 2】

前記（A 1）成分の全構成単位の合計に対して、前記構成単位（a 1）と（a 2）の合計の含有割合が50モル%以上であり、該構成単位（a 1）と（a 2）の合計に対して、（a 2）の含有割合が10モル%以上であることを特徴とする請求項1記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項 3】

当該ポジ型レジスト組成物が、K r F エキシマレーザー又は電子線露光用であることを特徴とする請求項1または2に記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項 4】

基板と、当該基板の上に設けられた磁性膜の上側、または、当該磁性膜の上に設けられた金属製の酸化防止膜の上側に設けられるレジスト層の形成用である請求項1～3のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項 5】

支持体上に下部有機層と上部レジスト層とが積層されているレジスト積層体であって、前記下部有機層が、アルカリ現像液に対して不溶性であり、且つドライエッチング可能なものであり、

前記上部レジスト層が、請求項1ないし4のいずれか記載のポジ型レジスト組成物からなるものであることを特徴とするレジスト積層体。

【請求項6】

前記下部有機層の厚さが300～20000nmであり、かつ前記上部レジスト層の厚さが50～1000nmである請求項5記載のレジスト積層体。

【請求項7】

請求項5または6のいずれか1項記載のレジスト積層体を形成する積層体形成工程と、前記レジスト積層体に対して選択的露光を行い、露光後加熱（PEB）を施し、アルカリ現像して前記上部レジスト層にレジストパターン（I）を形成する第1のパターン形成工程と、

前記レジストパターン（I）をマスクとしてドライエッチングを行い、前記下部有機層にレジストパターン（II）を形成する第2のパターン形成工程と、

前記レジストパターン（I）と（II）をマスクとしてエッチングを行い、前記支持体に微細パターンを形成するエッチング工程を有することを特徴とするレジストパターン形成方法。

【請求項8】

前記第2のパターン形成工程におけるドライエッチングが、酸素プラズマを用いたエッチングである請求項7記載のレジストパターン形成方法。

【請求項9】

前記エッチング工程におけるエッチングが、ハロゲン系ガスを用いたエッチングである請求項7または8記載のレジストパターン形成方法。

【請求項10】

さらに、前記第1のパターン形成工程の後、前記第2のパターン形成工程の前に、前記レジストパターン（I）上に水溶性ポリマーを含有する水溶性樹脂被覆を設けた後、加熱することによって前記レジストパターン（I）の間隔を狭小せしめる工程を有する請求項7～9のいずれかに記載のレジストパターン形成方法。

【請求項11】

前記水溶性ポリマーとして、プロトン供与性を有する少なくとも1種のモノマーから誘導される構成単位と、プロトン受容性を有する少なくとも1種のモノマーから誘導される構成単位とを含むものを用いる請求項10記載のレジストパターン形成方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】ポジ型レジスト組成物、レジスト積層体、およびレジストパターン形成方法

【技術分野】

【0001】

本発明は、シルセスキオキサン樹脂を用いたポジ型レジスト組成物、該ポジ型レジストを2層レジストプロセスの上層に用いたレジスト積層体、および該レジスト積層体を用いたレジストパターン形成方法に関する。

【背景技術】

【0002】

半導体素子や液晶表示素子の製造においては、基板上のレジストに回路パターン（レジストパターン）を形成するリソグラフィー工程と、該レジストパターンをマスク材として、基板上に形成されている絶縁膜、導電膜を部分的にエッチング除去するエッチング工程が行われている。

近年、リソグラフィー技術の進歩により、レジストパターンの微細化が急速に進んでいる。最も微細なプロセスでは、単層レジストプロセスで約100nm以下のラインアンドスペース、さらには70nm以下のアイソレートパターンを形成可能な解像度が求められるようになっている。

しかしながら、このような単層レジストプロセスでは、高解像性や良好なパターン形状を得ることが容易ではなく、ましてや高アスペクト比でこのような高解像性や良好なパターン形状を得るのはいっそう難しくなってきている。

【0003】

他方、高解像度で高アスペクト比のレジストパターンを形成可能な方法の1つとして、化学增幅型レジストを用いた二層レジスト法が提案されている（例えば、特許文献1、2参照）。この方法では、まず、基板上に、下部有機層として有機膜を形成したのち、その上に、化学增幅型レジストを用いて上部レジスト層を形成する。次いで、該上部レジスト層に、ホトリソグラフィー技術によりレジストパターンを形成した後、これをマスクとしてエッチングを行い、下部有機層にそのレジストパターンを転写することにより、高アスペクト比のレジストパターンを形成する。

また、例えば下記特許文献3では、二層レジスト法における上部レジスト層に好適な材料として、酸解離性溶解抑制基を導入した構成単位を有するシリコーン樹脂を用いた化学增幅型レジストが提案されている。

【特許文献1】特開平6-202338号公報

【特許文献2】特開平8-29987号公報

【特許文献3】特開平9-87391号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら、従来のシリコーン樹脂を用いた化学增幅型レジストにあっては、焦点深度や露光余裕度といったリソグラフィー特性において十分とは言えず、また条件によってラインエッジラフネスやレジストパターンの断面形状等の形状特性が劣化し易いという問題もあった。

【0005】

本発明の課題は、シリコーン樹脂を用いた化学增幅型レジスト組成物であって、上記リソグラフィー特性やレジストパターンの形状特性に優れたポジ型レジスト組成物、該レジスト組成物を用いたレジスト積層体、および該レジスト積層体を用いたレジストパターン形成方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

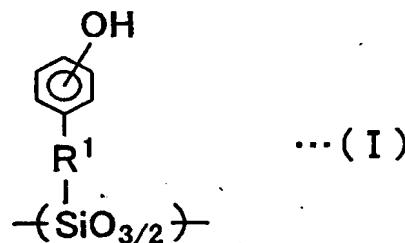
本発明者らは、鋭意検討を行った結果、特定の構成単位を有するシリセスキオキサン樹

脂をベース樹脂として含有するポジ型レジスト組成物、該ポジ型レジスト組成物を用いたレジスト積層体、該レジスト積層体を用いたレジストパターン形成方法が、上記課題を解決することを見出し、本発明を完成させた。

すなわち、前記課題を解決する本発明の第1の発明は、酸の作用によりアルカリ可溶性が増大する樹脂成分(A)と、露光により酸を発生する酸発生剤成分(B)とを含むポジ型レジスト組成物であって、前記(A)成分が、(a1)下記一般式(I)で表される構成単位、(a2)下記一般式(II)で表される構成単位、および(a3)下記一般式(III)で表される構成単位を有するシリセスキオキサン樹脂(A1)を含有してなることを特徴とするポジ型レジスト組成物である。

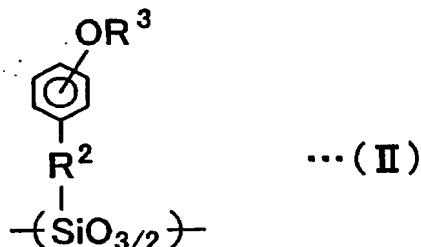
【0007】

【化1】



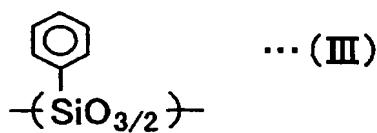
(式中、R¹は炭素数1～5の直鎖状または分岐状のアルキレン基を表す。)

【化2】



(式中、R²は炭素数1～5の直鎖状または分岐状のアルキレン基を表し、R³は酸解離性溶解抑制基を表す。)

【化3】



【0008】

本発明の第2の発明は、支持体上に下部有機層と上部レジスト層とが積層されているレジスト積層体であって、前記下部有機層が、アルカリ現像液に対して不溶性であり、且つドライエッチング可能なものであり、前記上部レジスト層が、本発明のポジ型レジスト組成物からなるものであることを特徴とするレジスト積層体である。

【0009】

本発明の第3の発明は、本発明のレジスト積層体を形成する積層体形成工程と、前記レジスト積層体に対して選択的露光を行い、露光後加熱(PEB)を施し、アルカリ現像して前記上部レジスト層にレジストパターン(I)を形成する第1のパターン形成工程と、前記レジストパターン(I)をマスクとしてドライエッチングを行い、前記下部有機層にレジストパターン(II)を形成する第2のパターン形成工程と、前記レジストパターン(I)と(II)をマスクとしてエッチングを行い、前記支持体に微細パターンを形成するエッチング工程を有することを特徴とするレジストパターン形成方法である。

【0010】

なお、本明細書において、「構成単位」とは、重合体を構成するモノマー単位を意味する。

【発明の効果】

【0011】

本発明によれば、焦点深度や露光余裕度といったリソグラフィー特性やレジストパターンの形状特性に優れたポジ型レジスト組成物、該レジスト組成物を用いたレジスト積層体、および該レジスト積層体を用いたレジストパターン形成方法が実現できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0012】

以下、本発明の実施形態を説明する。

[レジスト組成物]

< (A) 成分 >

本発明のポジ型レジスト組成物の樹脂成分(A)は、(a1)前記一般式(I)で表される構成単位、(a2)前記一般式(II)で表される構成単位、および(a3)前記一般式(III)で表される構成単位を有するシルセスキオキサン樹脂(A1)を含有する。

【0013】

構成単位(a1)において、R¹としては樹脂合成上の点から、炭素数1～5の低級アルキレン基が好ましく、中でもメチレン基がより好ましい。水酸基の位置はo位、m位、又はp位のいずれでもよいが、p位が工業的には好ましい。

構成単位(a2)において、R²としては同様に樹脂合成上の点から、炭素数1～5の低級アルキレン基が好ましく、中でもメチレン基がより好ましい。

構成単位(a2)におけるR³は、酸解離性溶解抑制基である。本発明において、「酸解離性溶解抑制基」とは、ホトレジスト組成物を用いたレジストパターン形成のプロセスにおいて、露光前は(A1)成分をアルカリ不溶とするアルカリ溶解抑制性を有するとともに、露光後は後述の酸発生剤成分(B)から発生した酸の作用により解離し、(A1)成分をアルカリ可溶性へ変化させる基である。従って、該(A1)成分を含むレジスト組成物を基板上に塗布し、マスクパターンを介して露光すると、露光部のアルカリ可溶性が増大し、アルカリ現像して、レジストパターンを形成することができる。

【0014】

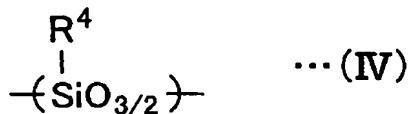
R³は、フェノール性OH基の水素原子と置換可能な酸解離性溶解抑制基であればよく、使用する光源に応じて、多数提案されているものの中から適宜選択して用いることができる。具体例としては、tert-ブトキシカルボニル基、tert-アミルオキシカルボニル基等の第三級アルキルオキシカルボニル基；tert-ブチル基、tert-アミル基等の第三級アルキル基；tert-ブトキシカルボニルメチル基、tert-ブトキシカルボニルエチル基等の第三級アルキコキシカルボニルアルキル基；1-エトキシエチル基、1-イソプロポキシエチル基、1-メトキシ-1-メチルエチル基、1-メトキシプロピル基、1-n-ブトキシエチル基等の低級アルコキシアルキル基；テトラヒドロビラニル基、テトラヒドロフラニル基等の環状エーテル基などが挙げられる。特に低級アルコキシアルキル基は脱離エネルギーが低く容易に溶解コントラストが得られる為、リソグラフィー特性が向上可能な点で好ましい。低級アルコキシアルキル基におけるアルコキシ基の炭素数は1～3、アルキル基の炭素数は1～6が好ましく、中でも1-エトキシエチル基が好ましい。(-OR³)の位置はo位、m位、又はp位のいずれでもよいが、p位が工業的には好ましい。

【0015】

(A1)成分は、前記構成単位(a1)～(a3)以外に、本発明の効果を損なわない構成単位(a4)を含有していてもよい。このような構成単位(a4)の具体例としては、下記一般式(IV)で表される構成単位が挙げられる。

【0016】

【化4】



(式中、R⁴は炭素数1～15の直鎖状、分岐状、または環状のアルキル基を示す。)

【0017】

各構成単位の樹脂中の割合は、(A1)成分の全構成単位の合計に対して、構成単位(a1)と構成単位(a2)の合計の含有割合が50モル%以上であり、残部すなわち50モル%以下が構成単位(a3)、または構成単位(a3)と(a4)の合計であることが好ましい。そして、構成単位(a1)と(a2)の合計に対して、(a2)の含有割合が8モル%以上であることが好ましい。

構成単位(a1)と(a2)の合計が50モル%より少ないとアルカリ現像工程における溶解性が不足するおそれがある。一方、(a3)は耐熱性の向上に寄与する構成単位であり、(A1)成分における構成単位(a3)の含有割合が10%未満となると、十分な耐熱性向上効果が得られない。

したがって、(a1)と(a2)の合計は、好ましくは50～90モル%、より好ましくは60～80モル%であり、構成単位(a3)、または構成単位(a3)と(a4)の合計は10～50モル%、好ましくは20～40モル%である。

【0018】

構成単位(a1)と(a2)の合計に対して、(a2)の含有割合が少ないと、酸解離性溶解抑制基(R³)を導入したことによる溶解抑制効果が低減するので、(A1)成分の露光前後のアルカリ溶解性の変化差が小さくなる。一方、(a2)の含有割合が多いと、露光およびPEB工程を経た後に、酸解離性溶解抑制基の一部が完全に解離されずに残るおそれがある。完全に解離されずに残った酸解離性溶解抑制基は、リムで除去されずにディフェクトの原因となることが多い。また、構成単位(a2)が多いと(A)成分の耐熱性が低下する傾向がある。

したがって、(a1)と(a2)の合計に対する(a2)の含有割合は、好ましくは8～25モル%、より好ましくは10～20モル%程度である。

【0019】

得ようとするレジストパターンの形状が、ラインアンドスペースパターンである場合、(A1)成分における構成単位(a3)の含有割合は、多いほどラインエッジラフネスが向上する。この場合、前記構成単位(a3)の含有割合は25～50モル%が好ましく、より好ましくは30～40モル%である。

また、得ようとするレジストパターンの形状が、ホールパターンである場合、(A1)成分における構成単位(a3)の含有割合が多いとホールパターンのエッジラフネスは向上するが、解像性が低下する傾向があるので、前記構成単位(a3)の含有割合は25～35モル%が好ましく、より好ましくは25～30モル%である。

【0020】

(A1)成分に、前記その他の構成単位(a4)を含有させる場合、その含有割合は25モル%以下とすることが好ましく、より好ましくは15モル%以下である。

【0021】

(A1)成分に用いられるシルセスキオキサン樹脂の質量平均分子量(Mw)(ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(以下、GPCと略記することもある)によるポリスチレン換算、以下同様。)は、特に限定するものではないが、好ましくは2000～15000、さらに好ましくは5000～10000とされる。この範囲よりも大きいと有機溶剤への溶解性が悪くなり、小さいとレジストパターン断面形状が悪くなるおそれがある。

また、Mw/数平均分子量(Mn)は、特に限定するものではないが、好ましくは1.

0~6.0、さらに好ましくは1.0~2.0である。この範囲よりも大きいと解像度、パターン形状が劣化するおそれがある。

【0022】

本発明におけるシルセスキオキサン樹脂(A1)は、例えば後述の合成例に示すように特許2567984号に記載の方法を利用して、構成単位(a1)と構成単位(a3)からなるポリマー、または構成単位(a1)と構成単位(a3)と構成単位(a4)からなるポリマーを得、次いで周知の手法で、構成単位(a1)の一部の側鎖のフェノール性水酸基の水素原子を酸解離性溶解抑制基と置換することにより製造することができる。なお、構成単位(a4)は、アルキルトリアルコキシランやアルキルトリクロロシランを、そのモノマーとして用いることができる。

【0023】

酸解離性溶解抑制基を導入する工程は、上記ポリマーを有機溶剤に溶解し、これに塩基又は酸性触媒、および導入しようとする酸解離性溶解抑制基に対応する化合物を添加し、20~70℃程度の温度で1~10時間程度反応を行った後、反応液に酸又は塩基を添加して反応を中和した後に、水中に攪拌投入してポリマーを析出させることで、構成単位(a1)と構成単位(a2)と構成単位(a3)からなるポリマー、または構成単位(a1)と構成単位(a2)と構成単位(a3)と構成単位(a4)からなるポリマーが得られる。なお、塩基又は酸性触媒は酸解離性溶解抑制基に対応する化合物によって使い分ければよい。

構成単位(a1)と構成単位(a2)の含有割合は、導入しようとする酸解離性溶解抑制基に対応する化合物の添加量によって制御することができる。

【0024】

<(B)成分>

(B)成分としては、従来化学增幅型レジストにおける酸発生剤として公知のものの中から任意のものを適宜選択して用いることができる。

【0025】

このような酸発生剤としては、これまで、ヨードニウム塩やスルホニウム塩などのオニウム塩系酸発生剤、オキシムスルホネート系酸発生剤、ビスマルキルまたはビスマリールスルホニルジアゾメタン類、ポリ(ビスマスルホニル)ジアゾメタン類、ジアゾメタニトロペンジルスルホネート類などのジアゾメタン系酸発生剤、イミノスルホネート系酸発生剤、ジスルホン系酸発生剤など多種のものが知られている。

【0026】

オニウム塩系酸発生剤の具体例としては、ジフェニルヨードニウムのトリフルオロメタンスルホネートまたはノナフルオロブタンスルホネート、ビス(4-tert-ブチルフェニル)ヨードニウムのトリフルオロメタンスルホネートまたはノナフルオロブタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート、トリ(4-メチルフェニル)スルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート、(4-メチルフェニル)ジフェニルスルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート、ジメチル(4-ヒドロキシナフチル)スルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネート、モノフェニルジメチルスルホニウムのトリフルオロメタンスルホネート、そのヘプタフルオロプロパンスルホネートまたはそのノナフルオロブタンスルホネートなどが挙げられる。これらのなかでもフッ素化アルキルスルホン酸イオンをアニオンとするオニウム塩が好ましい。

【0027】

オキシムスルホネート系酸発生剤の具体例としては、 α -(メチルスルホニルオキシ

ミノ) -フェニルアセトニトリル、 α - (メチルスルホニルオキシイミノ) -p-メトキシフェニルアセトニトリル、 α - (トリフルオロメチルスルホニルオキシイミノ) -フェニルアセトニトリル、 α - (トリフルオロメチルスルホニルオキシイミノ) -p-メトキシフェニルアセトニトリル、 α - (エチルスルホニルオキシイミノ) -p-メトキシフェニルアセトニトリル、 α - (プロピルスルホニルオキシイミノ) -p-メチルフェニルアセトニトリル、 α - (メチルスルホニルオキシイミノ) -p-プロモフェニルアセトニトリル、ビス-O-(n-ブチルスルホニル) - α -ジメチルグリオキシムなどが挙げられる。これらの中で、 α - (メチルスルホニルオキシイミノ) -p-メトキシフェニルアセトニトリル、ビス-O-(n-ブチルスルホニル) - α -ジメチルグリオキシムが好ましい。

【0028】

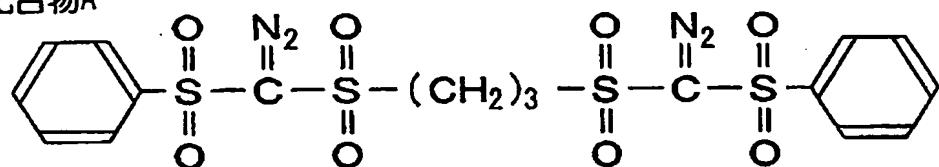
ジアゾメタン系酸発生剤の具体例は、ビス(n-プロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(イソプロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(n-ブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(イソプロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(tetra-ブチルスルホニル)ジアゾメタンなどの炭素数1～4の直鎖状または分岐状アルキル基を有するビスアルキルスルホニルジアゾメタン、ビス(シクロペンチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメタンなどの炭素数5～6の環状アルキル基を有するビスアルキルスルホニルジアゾメタン、ビス(p-トルエンスルホニル)ジアゾメタン、ビス(2,4-ジメチルフェニルスルホニル)ジアゾメタシなどのアリール基を有するビスアリールスルホニルジアゾメタシ等のジアゾメタンを挙げることができる。

また、ポリ(ビススルホニル)ジアゾメタン類としては、例えば、以下に示す構造をもつ1,3-ビス(フェニルスルホニルジアゾメチルスルホニル)プロパン(化合物A、分解点135℃)、1,4-ビス(フェニルスルホニルジアゾメチルスルホニル)ブタン(化合物B、分解点147℃)、1,6-ビス(フェニルスルホニルジアゾメチルスルホニル)ヘキサン(化合物C、融点132℃、分解点145℃)、1,10-ビス(フェニルスルホニルジアゾメチルスルホニル)デカン(化合物D、分解点147℃)、1,2-ビス(シクロヘキシルスルホニルジアゾメチルスルホニル)エタン(化合物E、分解点149℃)、1,3-ビス(シクロヘキシルスルホニルジアゾメチルスルホニル)プロパン(化合物F、分解点153℃)、1,6-ビス(シクロヘキシルスルホニルジアゾメチルスルホニル)ヘキサン(化合物G、融点109℃、分解点122℃)、1,10-ビス(シクロヘキシルスルホニルジアゾメチルスルホニル)デカン(化合物H、分解点116℃)などを挙げることができる。

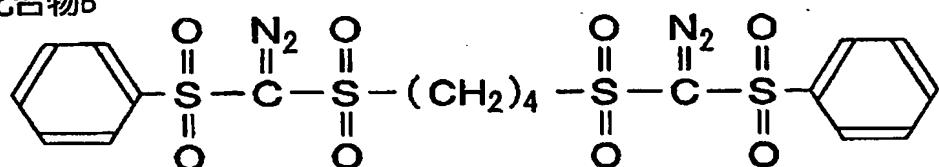
【0029】

【化5】

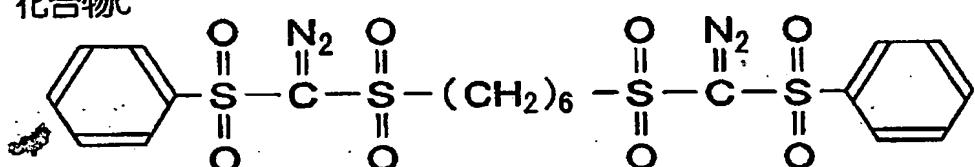
化合物A



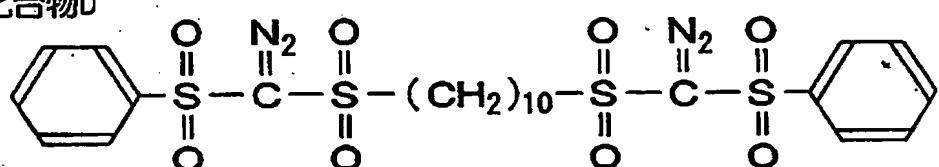
化合物B



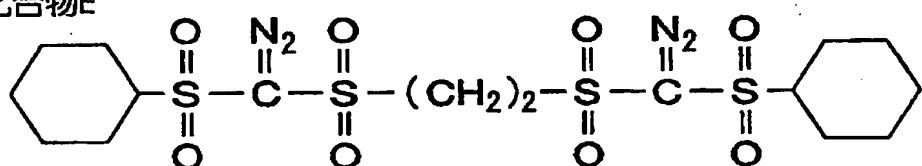
化合物C



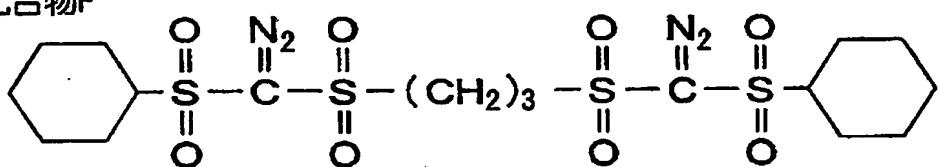
化合物D



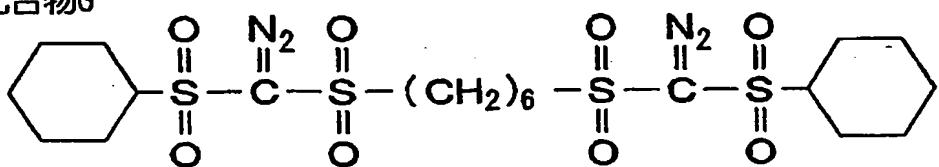
化合物E



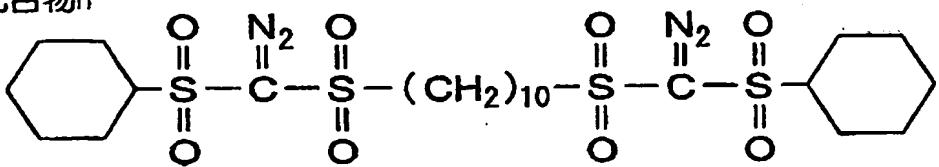
化合物F



化合物G



化合物H



【0030】

オニウム塩は焦点深度幅や露光マージンに優れ、好ましい。また、ジアゾメタンはレジ

ストホールパターンのサキュラリティ (circularity) を向上できたり、断面パターンの定在波を抑制でき好ましい。

【0031】

また、本発明においては、(B) 成分が、炭素数が 3 または 4 のパーカルオロアルキルスルホネートをアニオンとするオニウム塩系酸発生剤（以下、C 3～4 オニウム塩と略記することがある）を含有すると、マスクリニアリティがよくなり、様々なサイズのあるパターンを、マスクに忠実に再現できるので好ましい。また、近接効果、DOF、露光マージン等にも優れたものとなる。パーカルオロアルキルスルホネートのアルキル基は、直鎖状でも分歧状でもよいが、直鎖状が好ましい。

(B) 成分として C 3～4 オニウム塩を配合する場合、(B) 成分中の C 3～4 オニウム塩の配合量は、50～100 質量% が好ましい。

また、(B) 成分として C 3～4 オニウム塩を配合する場合、さらに、炭素数が 1 のパーカルオロアルキルスルホネートをアニオンとするオニウム塩系酸発生剤（以下、C 1 オニウム塩と略記することがある）を併用することが好ましい。

【0032】

オニウム塩のなかでも、トリフェニルスルホニウム塩は、分解しにくく有機ガスを発生しにくいので、好ましく用いられる。トリフェニルスルホニウム塩の配合量は、(B) 成分の合計に対し、好ましくは 30～100 モル%、より好ましくは 50～100 モル% とすることが好ましい。特には、オニウム塩とジアゾメタンを混合すると上記焦点深度幅や露光マージンを損なうことなく、レジストホールパターンのサキュラリティ (circularity) を向上できたり、断面パターンの定在波を抑制でき好ましい。この混合物の場合は、混合物におけるオニウム塩含有量が 20～90 モル%、より好ましくは 30～70 モル% である。

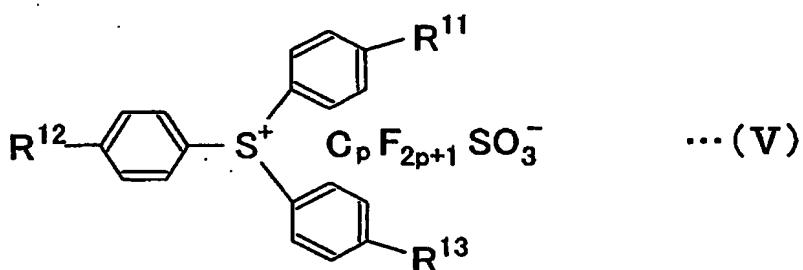
なお、オニウム塩のなかで、ヨードニウム塩は、ヨウ素を含む有機ガスの原因となることもある。

【0033】

また、トリフェニルスルホニウム塩のうち、特に、下記一般式 (V) で表される、パーカルオロアルキルスルホン酸イオンをアニオンとするトリフェニルスルホニウム塩は、高感度化できるので、好ましく用いられる。

【0034】

【化6】



[式中、R^{1 1}、R^{1 2}、R^{1 3} は、それぞれ独立に、水素原子、炭素数 1～8、好ましくは 1～4 の低級アルキル基、又は塩素、フッ素、臭素等のハロゲン原子であり；p は 1～12、好ましくは 1～8、より好ましくは 1～4 の整数である]

【0035】

(B) 成分は単独で用いてもよいし、2 種以上を組み合わせて用いてもよい。

その配合量は、(A) 成分 100 質量部に対し、0.5～30 質量部、好ましくは 1～10 質量部とされる。0.5 質量部未満ではパターン形成が十分に行われないし、30 質量部を超えると均一な溶液が得られにくく、保存安定性が低下する原因となるおそれがある。

【0036】

<有機溶剤>

また、本発明のポジ型レジスト組成物は、前記(A)成分と前記(B)成分と、後述する任意の成分を、好ましくは有機溶剤に溶解させて製造される。

有機溶剤としては、前記(A)成分と前記(B)成分を溶解し、均一な溶液とすることができますものであればよく、従来化学增幅型レジストの溶剤として公知のものの中から任意のものを1種又は2種以上適宜選択して用いることができる。

【0037】

例えば、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、メチルイソアミルケトン、2-ヘプタノンなどのケトン類や、エチレングリコール、エチレングリコールモノアセテート、ジエチレングリコール、ジエチレングリコールモノアセテート、プロピレングリコール、プロピレングリコールモノアセテート、ジプロピレングリコール、又はジプロピレングリコールモノアセテートのモノメチルエーテル、モノエチルエーテル、モノプロピルエーテル、モノブチルエーテル又はモノフェニルエーテルなどの多価アルコール類及びその誘導体や、ジオキサンのような環式エーテル類や、乳酸メチル、乳酸エチル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、ピルピン酸メチル、ピルピン酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチルなどのエステル類などを挙げることができる。これらの有機溶剤は単独で用いてもよく、2種以上の混合溶剤として用いてもよい。

【0038】

本発明においては、プロピレングリコールモノメチルエーテル(PGME)と、PGMEよりも高沸点の溶剤との混合溶剤が好ましく用いられる。これにより、ラインエッジラフネス、ラインワイズラフネス(ラインの左右の幅の不均一性)等のレジストパターン形状が向上する。また、コンタクトホールでの焦点深度幅(DOF)も広がる。

なお、ラインエッジラフネスとは、ライン側壁の不均一な凹凸のことである。ラインアンドスペースパターンのラインエッジラフネスを示す尺度である3σを求める。3σは、側長SEM(日立製作所社製、商品名「S-9220」)により、試料のレジストパターンの幅を32箇所測定し、その結果から算出した標準偏差(σ)の3倍値(3σ)である。この3σは、その値が小さいほどラフネスが小さく、均一幅のレジストパターンが得られたことを意味する。

PGMEよりも高沸点の溶剤としては、例えば上に例示した溶剤のうち、沸点が、PGMEの沸点である120℃を超えるもの、好ましくは沸点が20℃以上高いもの、より好ましくは25℃以上高いものが好ましい。また、該沸点の上限値としては、特に制限はないが、およそ200℃以下が好ましい。このような溶剤としては、例えばプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(沸点146℃)、EL(沸点155℃)、γ-ブチロラクトン(沸点204℃)等が挙げられる。これらの中でも、ELが好ましい。混合溶剤中のPGMEの配合量は、全混合溶剤中、10~60質量%が好ましく、20~40質量%がより好ましい。この範囲内であると、上記効果に優れる。

【0039】

<(C)成分>

本発明のポジ型レジスト組成物には、レジストパターン形状、引き置き経時安定性などを向上させるために、さらに任意の成分として、含窒素有機化合物(C)(以下、(C)成分という)を配合させることができる。

この(C)成分は、既に多種多様なものが提案されているので、公知のものから任意に用いれば良いが、アミン、特に第2級脂肪族アミンや第3級脂肪族アミンが好ましい。

(C)成分の具体例としては、トリメチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、ジ-n-プロピルアミン、トリ-n-プロピルアミン、トリペンチルアミン、トリ-n-ヘプチルアミン、トリ-n-オクチルアミン、ジ-n-ヘプチルアミン、ジ-n-オクチルアミン、トリ-n-ドデシルアミン等のアルキルアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、ジイソプロパノールアミン、トリイソプロパノールアミン、ジ-n-オクタノールアミン、トリ-n-オクタノールアミン等のアルキルアルコールのアミンが挙げられる。これらは単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよい。

これらは、(A)成分100質量部に対して、通常0.01～5.0質量部の範囲で用いられる。

【0040】

<(D)成分>

また、前記(C)成分との配合による感度劣化を防ぎ、またレジストパターン形状、引き置き安定性等の向上の目的で、さらに任意の成分として、有機カルボン酸又はリンのオキソ酸若しくはその誘導体(D)(以下、(D)成分という)を含有させることができる。なお、(C)成分と(D)成分は併用することもできるし、いずれか1種を用いることもできる。

有機カルボン酸としては、例えば、マロン酸、クエン酸、リンゴ酸、コハク酸、安息香酸、サリチル酸などが好適である。

リンのオキソ酸若しくはその誘導体としては、リン酸、リン酸ジ-*n*-ブチルエステル、リン酸ジフェニルエステルなどのリン酸又はそれらのエステルのような誘導体、ホスホン酸、ホスホン酸ジメチルエステル、ホスホン酸-*n*-ブチルエステル、フェニルホスホン酸、ホスホン酸ジフェニルエステル、ホスホン酸ジベンジルエステルなどのホスホン酸及びそれらのエステルのような誘導体、ホスフィン酸、フェニルホスフィン酸などのホスフィン酸及びそれらのエステルのような誘導体が挙げられ、これらの中で特にホスホン酸が好ましい。

(D)成分は、(A)成分100質量部当り好ましくは0.01～5.0質量部の割合で用いられる。

【0041】

本発明のポジ型レジスト組成物には、さらに所望により混和性のある添加剤、例えばレジスト膜の性能を改良するための付加的樹脂、塗布性を向上させるための界面活性剤、溶解抑制剤、可塑剤、安定剤、着色剤、ハレーション防止剤などを添加含有させることができる。

溶解抑制剤は必須ではないが、これをポジ型レジスト組成物に含有させることにより、ラインエッジラフネスを効果的に向上させることができる。

【0042】

溶解抑制剤としては、フェノール性水酸基またはカルボキシル基の水素原子の少なくとも1つが酸解離性溶解抑制基で置換された化合物であり、すでに3成分系化学增幅型ポジ型レジスト組成物において用いられている公知の溶解抑制剤を使用することができる。溶解抑制剤としては質量平均分子量が1000以下のものが好ましく用いられる。

【0043】

溶解抑制剤を構成し得るフェノール性水酸基を有する化合物としては、フェノール性水酸基を3～5個有するポリフェノール化合物、例えば核置換基としてヒドロキシル基を有するトリフェニルメタン系化合物、ビス(フェニルメチル)ジフェニルメタン系化合物、1,1-ジフェニル-2-ビフェニルエタン系化合物がある。また、フェノール、m-クレゾール、2,5-キシレノールから選ばれる少なくとも1種のフェノール類をホルマリン縮合して得られる2～6核体も用いることができる。

また、カルボキシル基が酸解離性溶解抑制基で保護されたカルボキシル化合物としては、例えば、ビフェニルカルボン酸、ナフタレン(ジ)カルボン酸、ベンゾイル安息香酸、アントラセンカルボン酸などが挙げられる。

【0044】

ポジ型レジスト組成物に溶解抑制剤を含有させる場合、その含有量は(A)成分に対して1～40質量%の範囲内が好ましく、10～30質量%がより好ましい。溶解抑制剤の使用量が上記範囲より少ないと添加効果が十分に得られず、多すぎるとパターン形状が劣化したり、リソグラフィー特性が悪化するので好ましくない。

【0045】

ここで、従来のシリコーン樹脂を用いた化学增幅型レジストにおける形状特性の劣化の原因としては、一般的にシリコーン樹脂自体が耐熱性に劣る傾向があり、酸解離性溶解抑

制基を解離させるためのP E B工程での加熱によってレジスト組成物のベース樹脂がダメージを受けやすいためと考えられる。例えば、P E Bにおける加熱温度が低過ぎると酸解離性溶解抑制基の解離が不十分となって所望の形状のレジストパターンが得られないので、P E Bの温度はある程度高くする必要があるが、それがレジスト組成物の耐熱温度を上回ると、レジストパターンが熱によって変形（フロー）してしまい、断面形状の劣化が生じる。

【0046】

これに対して、本発明のポジ型レジスト組成物によれば、ラインエッジラフネスおよび断面形状といった形状特性に優れたレジストパターンを実現することができる。特にホールパターンにあっては、上方から見たときのラフネスが低減され、形状特性（サキュラリティcircularity）が良好となり、ホール形状のレジストパターン形成に好適である。本発明のポジ型レジスト組成物は、ベース樹脂を構成するシルセスキオキサン樹脂（A1）に前記構成単位（a3）を含有させることにより、該構成単位（a3）を含有しないシルセスキオキサン樹脂に比べて耐熱性が向上され、これによって良好な形状特性が安定して得られるものと考えられる。

また本発明のポジ型レジスト組成物は、解像性が高いうえ、焦点深度が広く、露光余裕度も良好である。特に構成単位（a1）を含有させることにより露光余裕度を効果的に向上させることができる。

またプリベーク温度を70～90℃程度と低めにすることにより、ホワイトエッジを効果的に改善することができる。

【0047】

本発明のポジ型レジスト組成物は、二層レジストを用いて支持体をパターニングする方法に好適に用いることができる。

以下、二層レジストとして用いられるレジスト積層体について説明する。

【0048】

【レジスト積層体】

本発明のレジスト積層体は、支持体上に、アルカリ現像液に対して不溶性であり、且つドライエッチング可能な下部有機層と、前記本発明のポジ型レジスト組成物からなる上部レジスト層とが積層されているものである。

【0049】

支持体としては、特に限定されず、従来公知のものを用いることができ、例えば、電子部品用の基板や、これに所定の配線パターンが形成されたものなどを例示することができる。

基板としては、例えばシリコンウェーハ、銅、クロム、鉄、アルミニウムなどの金属製の基板や、ガラス基板などが挙げられる。

配線パターンの材料としては、例えば銅、アルミニウム、ニッケル、金などが使用可能である。

【0050】

下部有機層は、露光後の現像の際に用いられるアルカリ現像液に対して不溶性であり、且つ従来のドライエッチング法でエッチング可能な有機膜である。

このような下部有機層を用いることにより、まず、通常のホトリソグラフィーにより上部レジスト層のみ露光・アルカリ現像して、レジストパターンを形成した後、該レジストパターンをマスクとして下部有機層をドライエッチングすることによって、下部有機層に上部レジスト層のレジストパターンが転写される。その結果、レジストパターンのパターン倒れを生じることなく、高アスペクト比のレジストパターンを形成することができる。

下部有機層を形成するための有機膜材料は、上層レジストのような感光性を必ずしも必要とするものではない。半導体素子や液晶表示素子の製造において、下地材として一般的に用いられている、レジストや樹脂を用いればよい。

【0051】

また、上層レジストパターンを下部有機層へ転写する必要があるので、下部有機層は、

酸素プラズマによるエッチングが可能な材料であることが好ましい。

このような材料としては、酸素プラズマによるエッチングを行いやすいと同時に、後工程でシリコン基板等のエッチングに用いられているフッ化炭素系ガスに対する耐性が強いことなどから、ノボラック樹脂、アクリル樹脂及び可溶性ポリイミドからなる群から選択される少なくとも一種を主成分とするものが好ましく用いられる。

これらの中でも、ノボラック樹脂、及び側鎖に脂環式部位又は芳香族環を有するアクリル樹脂は、安価で汎用的に用いられ、後工程のドライエッチング耐性に優れるので、好ましく用いられる。

【0052】

ノボラック樹脂としては、ポジ型レジスト組成物に一般的に用いられているものが使用可能であるし、ノボラック樹脂を主成分として含む i 線や g 線用のポジレジストも使用可能である。

ノボラック樹脂は、例えば、フェノール性水酸基を持つ芳香族化合物（以下、単に「フェノール類」という。）とアルデヒド類とを酸触媒下で付加縮合させることにより得られる樹脂である。

【0053】

フェノール類としては、例えばフェノール、o-クレゾール、m-クレゾール、p-クレゾール、o-エチルフェノール、m-エチルフェノール、p-エチルフェノール、o-ブチルフェノール、m-ブチルフェノール、p-ブチルフェノール、2, 3-キシレノール、2, 4-キシレノール、2, 5-キシレノール、2, 6-キシレノール、3, 4-キシレノール、3, 5-キシレノール、2, 3, 5-トリメチルフェノール、3, 4, 5-トリメチルフェノール、p-フェニルフェノール、レゾルシノール、ヒドロキノン、ヒドロキノンモノメチルエーテル、ピロガロール、フロログリシノール、ヒドロキシジフェニル、ビスフェノールA、没食子酸、没食子酸エステル、 α -ナフトール、 β -ナフトール等が挙げられる。

【0054】

またアルデヒド類としては、例えばホルムアルデヒド、フルフラール、ベンズアルデヒド、ニトロベンズアルデヒド、アセトアルデヒド等が挙げられる。

付加縮合反応時の触媒は、特に限定されるものではないが、例えば酸触媒では、塩酸、硝酸、硫酸、蟻酸、蔴酸、酢酸等が使用される。

上記ノボラック樹脂は、質量平均分子量が 3000～10000、好ましくは 6000～9000、さらに好ましくは 7000～8000 の範囲内のものが好ましい。質量平均分子量が 3000 未満であると、高温でペークしたときに昇華してしまうことがあり、また、質量平均分子量が 10000 を超えると、ドライエッチングしにくくなる傾向があり、好ましくない。

【0055】

本発明において使用可能なノボラック樹脂は、市販されているものを使用することもでき、例えば、TBL C-100（商品名；東京応化工業社製）が挙げられる。ただし、特に質量平均分子量（M_w）が 5000～50000、好ましくは 8000～30000 であり、かつ分子量 500 以下、好ましくは 200 以下の低核体の含有量が、ゲルパーセンションクロマトグラフィー法において 1 質量% 以下、好ましくは 0.8 質量% 以下であるノボラック樹脂が好ましい。低核体の含有量は、少ないほど好ましく、望ましくは 0 質量% である。

【0056】

「分子量 500 以下の低核体」とは、ポリスチレンを標準として GPC 法により分析した際に分子量 500 以下の低分子フラクションとして検出されるものである。「分子量 500 以下の低核体」には、重合しなかったモノマーや、重合度の低いもの、例えば、分子量によっても異なるが、フェノール類 2～5 分子がアルデヒド類と縮合したものなどが含まれる。

分子量 500 以下の低核体の含有量（質量%）は、この GPC 法による分析結果を、横出証特 2004-3050283

軸にフラクション番号、縦軸に濃度をとてグラフとし、全曲線下面積に対する、分子量500以下の低分子フラクションの曲線下面積の割合(%)を求ることにより測定される。

【0057】

ノボラック樹脂のM_wを50000以下とすることにより、微細な凹凸を有する基板に対する良好な埋め込み特性が優れ、また、M_wを5000以上とすることにより、フッ化炭素系ガス等に対するエッチング耐性が優れるので好ましい。

また、分子量500以下の低核体の含有量が1質量%以下であることにより、微細な凹凸を有する基板に対する埋め込み特性が良好になる。低核体の含有量が低減されていることにより埋め込み特性が良好になる理由は明らかではないが、分散度が小さくなるためと推測される。

【0058】

アクリル樹脂としては、ポジ型レジスト組成物に一般的に用いられているものが使用可能であり、例えば、エーテル結合を有する重合性化合物から誘導された構成単位と、カルボキシル基を有する重合性化合物から誘導された構成単位を含有するアクリル樹脂を挙げることができる。

【0059】

エーテル結合を有する重合性化合物としては、2-メトキシエチル(メタ)アクリレート、メトキシリエチレンゲリコール(メタ)アクリレート、3-メトキシプロピル(メタ)アクリレート、エチルカルビトール(メタ)アクリレート、フェノキシポリエチレンゲリコール(メタ)アクリレート、メトキシポリプロピレンゲリコール(メタ)アクリレート、テトラヒドロフルフリル(メタ)アクリレート等のエーテル結合及びエステル結合を有する(メタ)アクリル酸誘導体等を例示することができる。これらの化合物は単独もしくは2種以上組み合わせて使用できる。

【0060】

カルボキシル基を有する重合性化合物としては、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸などのモノカルボン酸；マレイン酸、フマル酸、イタコン酸などのジカルボン酸；2-メタクリロイルオキシエチルコハク酸、2-メタクリロイルオキシエチルマレイン酸、2-メタクリロイルオキシエチルフタル酸、2-メタクリロイルオキシエチルヘキサヒドロフタル酸などのカルボキシル基及びエステル結合を有する化合物等を例示することができ、好ましくは、アクリル酸、メタクリル酸である。これらの化合物は単独もしくは2種以上組み合わせて使用できる。

【0061】

可溶性ポリイミドとは、上述のような有機溶剤により液状にできるポリイミドである。

【0062】

本発明のレジスト積層体において、上部レジスト層及び下部有機層の厚さは、目的とするアスペクト比と下部有機層のドライエッチングに要する時間を考慮したスループットのバランスから、トータルとして、好ましくは15μm以下、より好ましくは5μm以下である。トータルの下限値は特に限定されないが、好ましくは0.1μm以上、より好ましくは0.35μm以上である。

上部レジスト層の厚さは、好ましくは50～1000nm、より好ましくは50～800nm、さらにより好ましくは100～500nmである。上部レジスト層の厚さをこの範囲内とすることにより、レジストパターンを高解像度で形成できる、ドライエッチングに対する十分な耐性が得られる等の効果がある。

下部有機層の厚さは、好ましくは300～20000nm、より好ましくは300nm～8000nm、さらにより好ましくは400～5000nmである。下部有機層の厚さをこの範囲内とすることにより、高アスペクト比のレジストパターンが形成できる、基板エッチング時に十分なエッチング耐性が確保できる等の効果がある。

【0063】

本発明においては、上部レジスト層の厚みを50～1000nm、下部有機層の厚みを

300~20000 nmとすることができる、このような厚膜であっても、パターン幅を小さくすることができ、高アスペクト比のパターン（下部有機層パターン）が形成できる。そのため、後述する電子線用、磁性膜のパターン形成用や、その他マイクロマシニング用途等、特に微細加工が要求される分野に好適である。

なお、本発明のレジスト積層体には、上部レジスト層や下部有機層にレジストパターンが形成されている積層体も、形成されていない積層体も含まれる。

レジストパターンが形成されたレジスト積層体において、アスペクト比が高いパターンを、パターン倒れ等を起さずに形成できることが好ましい。パターンが高いアスペクト比を有するほど、後述のような支持体への微細パターン形成を、より精度良く行うことができる。

ここでいうアスペクト比とは、レジストパターンのパターン幅 x に対する、下部有機層の高さ y の比 (y/x) である。尚、レジストパターンのパターン幅 x は、下部有機層に転写した後のパターン幅と同じである。

パターン幅とは、レジストパターンがラインアンドスペースパターン、孤立ラインパターン等のライン状パターンである場合は、凸条（ライン）の幅をいう。レジストパターンがホールパターンである場合、パターン幅とは、形成された孔（ホール）の内径をいう。また、レジストパターンが円柱状ドットパターンである場合は、その直径をいう。なお、これらのパターン幅は、いずれもパターン下方の幅である。

本発明のポジ型レジスト組成物によれば、高アスペクト比のパターンを容易に与えることができる。ドットパターン又は孤立ラインパターンの場合、例えば膜厚2.5 μmの下部有機層に対して従来のレジスト組成物では達成することができないアスペクト比8以上20以下のドットパターン又は孤立ラインパターンを作成することができる。トレンチパターンの場合、例えば膜厚2.5 μmの下部有機層に対して通常のレジスト組成物では達成することができないアスペクト比10以上20以下のトレンチパターンを作成することができる。いずれも、従来のレジスト組成物ではアスペクト比5付近が限界である。

【0064】

【レジストパターン形成方法】

このようなレジスト積層体を用いてレジストパターンを形成する方法は、例えば以下のようにして行うことができる。

まず、シリコンウェーハのような基板上に、下部有機層を形成するためのレジスト組成物や樹脂溶液を、スピナーなどで塗布し、好ましくは200~300°C、30~300秒間、好ましくは60~180秒間の加熱条件でペーク処理し、下部有機層を形成する。

なお、下部有機層と上部レジスト層の間には、有機系または無機系の反射防止膜が設けられていてもよい。

【0065】

次に、下部有機層上に、本発明のポジ型レジスト組成物をスピナーなどで塗布し、70~130°Cの温度条件下、プレベークを40~180秒間、好ましくは60~90秒間施し、上部レジスト層を形成して、本発明のレジスト積層体を得る。

このレジスト積層体に対し、例えばKrF露光装置などにより、KrFエキシマレーザー光を所望のマスクパターンを介して選択的に露光した後、PEB（露光後加熱）を、70~130°Cの温度条件下、40~180秒間、好ましくは60~90秒間施す。

次いで、これをアルカリ現像液、例えば0.05~1.0質量%、好ましくは0.05~3質量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液を用いて現像処理する。このようにして、上部レジスト層に、マスクパターンに忠実なレジストパターン（I）を形成することができる。

【0066】

露光に使用する光源としては、特にKrFエキシマレーザー、電子線が有用であるが、ArFエキシマレーザー、F₂エキシマレーザー、EUV（極紫外線）、VUV（真空紫外線）、電子線、X線、軟X線などの放射線に対しても有効である。電子線を用いる場合は、マスクを介しての選択的電子線照射であっても、描画であってもよい。

本発明のポジ型レジスト組成物及びこれからなるレジスト層は、微細なレジストパターンが形成された場合にも、レジストパターンのラインエッジラフネスおよび断面形状の矩形性が良好であり、またパターン倒れ等の問題を生じないので、高度の微細加工が図られる、電子線が好適である。

【0067】

次に、得られたレジストパターン（I）をマスクパターンとして、下部有機層のドライエッチングを行い、下部有機層にレジストパターン（II）を形成する。

ドライエッチングの方法としては、ダウンフローエッチングやケミカルドライエッチング等の化学的エッチング；スパッタエッチングやイオンビームエッチング等の物理的エッチング；RIE（反応性イオンエッチング）等の化学的・物理的エッチングなどの公知の方法を用いることができる。

【0068】

最も一般的なドライエッチングは、平行平板型RIEである。この方法では、まず、RIE装置のチャンバーにレジスト積層体を入れ、必要なエッチングガスを導入する。チャンバー内の、上部電極と平行に置かれたレジスト積層体のホルダーに高周波電圧を加えると、ガスがプラズマ化される。プラズマ中では正・負のイオンや電子などの電荷粒子、中性活性種などがある。これらのエッチング種が下部有機層に吸着すると、化学反応が生じ、反応生成物が表面から離脱して外部へ排気され、エッチングが進行する。

【0069】

エッチングガスとしては、酸素、二酸化硫黄等があるが、酸素プラズマによるエッチングは解像度が高いこと、本発明のシルセスキオキサン樹脂（A1）が酸素プラズマに対する耐エッチング性が高いこと、汎用的に用いられている等の理由で、好ましくは酸素が用いられる。

【0070】

このようにしてレジストパターン（I）とレジストパターン（II）が積層されたレジストパターンが得られるので、これをマスクとしてエッチングを行うことによって支持体に微細パターンを形成することができる。

このときのエッチング法としてはハロゲン系ガスを用いたエッチング法を好ましく用いることができる。

【0071】

本発明のレジストパターン形成方法によれば、下部有機層と上部レジスト層が積層された積層体を用いてレジストパターンを形成するので、アスペクト比が高いパターンを形成する場合でも上部レジスト層を薄膜化することができる。一般的に、上部レジスト層を薄膜化することによって解像性が向上する一方で、ラインエッジラフネスやホールパターンのエッジラフネス（まとめてエッジラフネスというときがある）が顕著となる傾向があるが、特に本発明における上部レジスト層を構成しているレジスト組成物は、薄膜化した場合にも好適なアルカリ溶解性を得ることができるので、エッジラフネスの発生を低減させることができる。

また特に（A）成分に含まれるシルセスキオキサン樹脂（A1）が、耐熱性に優れるものであるので、加熱工程を経ても断面形状が良好なレジストパターンが得られる。例えば、該シルセスキオキサン樹脂（A1）は、酸解離性溶解抑制基を有する構成単位（a2）を有するので、PEB工程において該酸解離性溶解抑制基が解離する程度に高い加熱を施す必要があるが、かかる加熱を行ってもレジストパターンの熱変形が防止される。

このようにして得られるレジストパターンの形状は、高アスペクト比であり、パターン倒れもなく、垂直性の高い良好なものである。

また、ホワイトエッジの発生を防止するには、プリペークにおける加熱温度を70～90℃程度とすることが効果的である。

【0072】

[レジストパターン狭小工程]

また、本発明のポジ型レジスト組成物は、狭小工程を有するレジストパターンの形成方

法にも好適に用いることができる。

狭小工程は、露光、現像工程を経て基板上にレジストパターンを形成した後、該レジストパターンを水溶性樹脂被覆で被覆した後、加熱処理によりレジストパターン間の間隔やホールパターンの孔径を狭小させる工程であり、これによって、よりいっそう微細なレジストパターンを形成することができる。

【0073】

より具体的には、まず、上述した手順で上部レジスト層にレジストパターン（I）を形成した後、該レジストパターン（I）上に、水溶性ポリマー等を含む被覆形成剤を塗布し、好ましくはレジストパターン全体の表面上に水溶性樹脂被覆を形成して被覆レジストパターンを形成する。なお、被覆形成剤を塗布した後に、80～120℃の温度で30～90秒間、基板にプリペークを施してもよい。塗布方法は、レジスト層等を形成するために従来用いられている公知の方法に従って行うことができる。すなわち、例えばスピナーラ等により、上記被覆形成剤の水溶液を基板上に塗布する。

次いで、得られた被覆レジストパターンに対して熱処理を行って、水溶性樹脂被覆を熱収縮させる。この水溶性樹脂被覆の熱収縮作用により、該水溶性樹脂被覆に接するレジストパターン（I）の側壁同士が互いに引き寄せられ、パターン間の間隔が狭められる。このホトレジストパターン間の間隔は、最終的に得られるパターンサイズ（ホールパターンの径やラインアンドスペースパターンの幅）を規定することから、水溶性樹脂被覆の熱収縮により、パターンサイズを狭小化させることができ、パターンの微小化を行うことができる。

【0074】

加熱温度は、水溶性樹脂被覆の収縮を起こし得る温度であって、パターンサイズを狭小させるのに十分な温度であれば、特に限定されるものでないが、レジストパターンの軟化点よりも低い温度で加熱するのが好ましい。このような温度での加熱処理により、プロファイルの良好なパターンの形成をより一層効果的に行うことができ、また特に基板面内における狭小量のピッチ依存性、すなわち基板面内におけるパターンサイズに対する狭小量の依存性を小さくすることができる等の点において極めて効果的である。

【0075】

なお「レジストパターンの軟化点」とは、基板上に形成したホトレジストパターンが、基板の加熱処理により自発的に流動化（フロー）し始める温度を意味する。レジストパターンの軟化点は、レジストパターンを形成するレジスト組成物によりそれぞれ異なる。現在のホトリソグラフィー技術において用いられる種々のレジスト組成物の軟化点を考慮すると、好ましい加熱処理は通常、80～160℃程度の温度範囲で、ただしレジストが熱流動を起さない温度で、30～90秒間程度行われる。

【0076】

また、水溶性樹脂被覆の厚さとしては、ホトレジストパターンの高さと同程度あるいはそれを覆う程度の高さが好ましく、通常、0.1～0.5μm程度が適當である。

【0077】

この後、パターン上に残留する熱収縮した水溶性樹脂被覆は、水系溶剤、好ましくは純水により10～60秒間洗浄することにより除去する。水溶性樹脂被覆は、水での洗浄除去が容易で、かつ、基板およびレジストパターンから完全に除去することができる。

そして、この後、得られたレジストパターン（I）をマスクパターンとして、上述したように下部有機層のドライエッチングを行い、下部有機層にレジストパターン（II）を形成する。

【0078】

水溶性樹脂被覆を形成する被覆形成剤に含まれる水溶性ポリマーは、室温で水に溶解し得るポリマーであればよく、特に制限されるものでないが、プロトン供与性を有する少なくとも1種のモノマーから誘導される構成単位と、プロトン受容性を有する少なくとも1種のモノマーから誘導される構成単位とを含むものが好ましく用いられる。このような樹脂を用いることにより、加熱による体積収縮が良好に行われる。

このような水溶性ポリマーとしては、プロトン供与性を有する少なくとも1種のモノマーから誘導される構成単位と、プロトン受容性を有する少なくとも1種のモノマーから誘導される構成単位とを有する共重合体を含むものであってもよく、また、プロトン供与性を有する少なくとも1種のモノマーから誘導される構成単位を有する重合体と、プロトン受容性を有する少なくとも1種のモノマーから誘導される構成単位を有する重合体との混合物を含むものであってもよいが、相溶性等を考慮すると、共重合体を用いることが好ましい。

このような水溶性ポリマーとしては、特に、工業上の点から、アクリル系重合体、ビニル系重合体、セルロース系誘導体、アルキレングリコール系重合体、尿素系重合体、メラミン系重合体、エポキシ系重合体、アミド系重合体などが好ましく用いられる。

【0079】

中でも、アルキレングリコール系重合体、セルロース系重合体、ビニル系重合体、アクリル系重合体の中から選ばれる少なくとも1種を含む構成とするのが好ましく、特に、pH調整が容易であるという点からアクリル系重合体が最も好ましい。さらには、アクリル系重合体と、アクリル系重合体以外の水溶性ポリマーとの共重合体とすることが、加熱処理時にホトレジストパターンの形状を維持しつつ、ホトレジストパターンサイズを効率よく狭小させることができるという点から好ましい。水溶性ポリマーは1種または2種以上を用いることができる。

プロトン供与性を有するモノマーとしては、例えば、アクリルアミドやN-ビニルピロリドンが好ましい。

プロトン受容性を有するモノマーとしては、例えば、アクリル酸が好ましい。

そして、プロトン供与性を有するモノマーとしてN-ビニルピロリドン、プロトン受容性を有するモノマーとしてアクリル酸を含む水溶性ポリマーが好ましい。

【0080】

被覆形成剤は、3～50質量%濃度の水溶液として用いるのが好ましく、5～20質量%濃度の水溶液として用いるのが特に好ましい。濃度が3質量%未満では基板への被覆不良となるおそれがあり、一方、50質量%超では、濃度を高めたことに見合う効果の向上が認められず、取扱い性の点からも好ましくない。

【0081】

なお、被覆形成剤は、上記したように溶媒として水を用いた水溶液として通常用いられるが、水とアルコール系溶媒との混合溶媒を用いることもできる。アルコール系溶媒としては、例えばメチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコール、イソプロピルアルコール等の1価アルコール等が挙げられる。これらのアルコール系溶媒は、水に対して30質量%程度を上限として混合して用いられる。

【0082】

【デュアルダマシン法】

また、本発明のポジ型レジスト組成物は、ビアファーストのデュアルダマシン法による半導体デバイスの製造に用いられる化学増幅型ポジ型レジストとして好適に用いることができ、特にレジスト残さ（ポイズニング）の発生防止に効果がある。以下詳述する。

半導体デバイスの微細化に伴って、半導体デバイスの製造プロセスは、これまでの反応性イオンエッティング（R I E）技術によってA1配線を形成する方法から、ダマシン技術によってA1・Cu配線またはCu配線を形成する方法に移行しはじめている。

ダマシン技術において、ビアホールと配線溝という2種類の被エッティング部を形成するものをデュアルダマシン法という。

デュアルダマシン法には、配線溝を先に形成するトレンチファーストとビアホールを先に形成するビアファーストの2種類の手法が存在する（平成10年5月30日、株式会社リアライズ社発行、深水克郎編、「Cu配線技術の最新の展開」、202～205ページ）。

【0083】

ビアファーストによって半導体デバイスを製造する方法においては、例えば、基板の上

に第一層間絶縁層、エッチングストッパー層、第二層間絶縁層が順次積層された基材を用意する。そして、化学増幅型のポジ型レジスト組成物を塗布し、所定のパターンにしたがって露光し、露光部分をアルカリ可溶化し、この露光部分をアルカリ現像液で除去し、そのレジストパターン以外の部分の下層をエッチングして、第一層間絶縁層、エッチングストッパー層、および第二層間絶縁層を貫通するピアホールを形成する。その後、さらに化学増幅型ポジ型レジスト組成物を塗布し、露光して、この露光部分をアルカリ可溶化し、この露光部分をアルカリ現像液で除去し、そのレジストパターン以外の部分の下層を、第二層間絶縁層に形成されたピアホールの溝幅を拡げる様にエッチングすることによって、配線溝を形成する。最後に第一層間絶縁層とエッチングストッパー層に形成されたピアホールと、その上の第二層間絶縁層に形成された配線溝に銅を埋め込み、断面略T字状の配線を完成させる。

【0084】

[磁性膜加工用のパターン形成]

本発明のポジ型レジスト組成物は、リソグラフィー特性やレジストパターンの形状特性に優れる。したがって、高度の微細加工が要求される磁性膜のパターン形成のためのレジストパターン形成用として、好適に用いられる。

すなわち、本発明のポジ型レジスト組成物は、基板と、当該基板の上に設けられた磁性膜の上側、または、当該磁性膜の上に設けられた金属製の酸化防止膜の上側に設けられるレジスト層の形成用として好適である。

具体的な用途としては、例えば、後述する磁気ヘッドのリード部、あるいはライト部の形成等が挙げられる。

【0085】

磁性膜のパターン形成を行う場合、まず、磁性膜加工用のレジストパターンを形成する。磁性膜加工用のレジストパターンを形成するにあたり、高アスペクト比のレジストパターンをより容易に得ることのできる、2層レジスト法を用いることが好ましい。

2層レジスト法による磁性膜加工用レジストパターン形成は、上記「レジストパターン形成方法」の項で示した支持体として、磁性膜を設けた磁性膜材料を用い、上記本発明のレジスト積層体を形成し、このレジスト積層体にレジストパターン（I）（I.I）を形成する方法で行うことができる。

【0086】

磁性膜材料としては、基板と、当該基板の上に設けられた磁性膜からなるもの、あるいは、当該磁性膜の上に金属製の酸化防止膜をさらに有するものが用いられる。

磁性膜加工用のレジストパターン形成は、さらに具体的には、下記（1）～（5）の工程で行うことができる。

- (1) 基板と、当該基板の上に設けられた磁性膜の上、または、当該磁性膜の上に設けられた金属製の酸化防止膜の上に、下部有機層を形成し、その上に、本発明のポジ型レジスト組成物からなる上部レジスト層を形成し、レジスト積層体を得る工程、
- (2) 当該レジスト積層体に選択的露光を行う工程、
- (3) 当該選択的露光を行ったレジスト積層体に対して、露光後加熱（PEB）を行う工程、
- (4) 当該露光後加熱を行ったレジスト積層体に対して、アルカリ現像を行い、上部レジスト層にレジストパターン（I）を形成する工程、
- (5) 得られたレジストパターン（I）をマスクパターンとして、下部有機層のドライエッティングを行い、下部有機層にレジストパターン（I.I）を形成する工程。

下部有機層の形成、上部レジスト層の形成、選択的露光、露光後加熱、現像処理、エッチング等の好ましい条件は、上記「レジストパターン形成方法」における例示と同様とできる。

【0087】

このようにしてレジストパターン（I）とレジストパターン（I.I）が積層された磁性膜加工用のレジストパターンが得られるので、これをマスクとしてエッチングを行うこと

によって、磁性膜に微細でかつ、高アスペクト比のパターンを形成することができる。

【0088】

例えば、前記磁性膜の主成分としては、鉄、コバルト、ニッケルのうちの1種以上が挙げられる。

また、前記磁性膜の上に設けられる金属製の酸化防止膜の主成分としては、タンタル、酸化アルミニウム (Al_2O_3) のうちの1種以上が挙げられる。

なお、主成分とは、例えば50質量%以上、好ましくは80質量%以上をしめる成分を指すものとする。

前記磁性膜、前記酸化膜の主成分以外の成分については、磁性膜またはその上に積層される金属製の酸化防止膜について公知の材料から適宜選択可能である。

なお、基板の上に磁性膜を形成する場合は、基板に直接接触する層として磁性膜が形成されていることが好ましく、金属製の酸化防止膜を形成する場合は、磁性膜の上に直接金属製の酸化防止膜が形成されていることが好ましい。

磁性膜、酸化防止膜の厚さは特に限定されない。

基板は例えばシリコン基板等が用いられる。

【0089】

「マイクロマシニング」

本発明のポジ型レジスト組成物は、上記磁性膜を用いる用途を含むマイクロマシニング等の、高アスペクト比のレジストパターンを用いた微細加工への要求が高い分野において好適である。

マイクロマシニングは、リソグラフィー技術を応用した立体的微細加工技術であり、基板上にセンサ、回路、微細構造体等の様々な要素を集積化した高度な小型システム、いわゆるMEMSの製造などに利用される。このようなリソグラフィー技術の応用の1つとして、リフトオフ法がある。リフトオフ法は、例えば、磁気記録媒体の磁気ヘッドのリード部（読み出し用ヘッド部）における微細構造の製造等に用いられている。

本発明のポジ型レジスト組成物からなり、下層に対し積層されたレジスト層は、高アスペクト比のレジストパターン形成に貢献することができるので、本発明のポジ型レジスト組成物は、リフトオフ法にも好適に応用することができる。

【実施例】

【0090】

次に、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例によって限定されるものではない。なお、配合量は特記しない限り質量%である。

【0091】

(シリセスキオキサン樹脂の合成例1)

かきませ機、還流冷却器、滴下ロート及び温度計を備えた500m^l三つ口フラスコに、炭酸水素ナトリウム84.0g(1.0mol)と水400m^lを投入したのち、滴下ロートより、p-メトキシベンジルトリクロロシラン51.1g(0.20mol)、ベンジルトリクロロシラン21.1g(0.10mol)及びジェチルエーテル100m^lの混合液を2時間で滴下し、さらに1時間熟成した。反応終了後、反応混合物をエーテルで抽出し、エーテルを減圧下留去したのち、得られた加水分解生成物へ水酸化カリウムの10重量%溶液0.2gを加え、200℃で2時間加熱することにより、p-メトキシベンジルシリセスキオキサンとベンジルシリセスキオキサンからなる共重合体A₁を得た。

【0092】

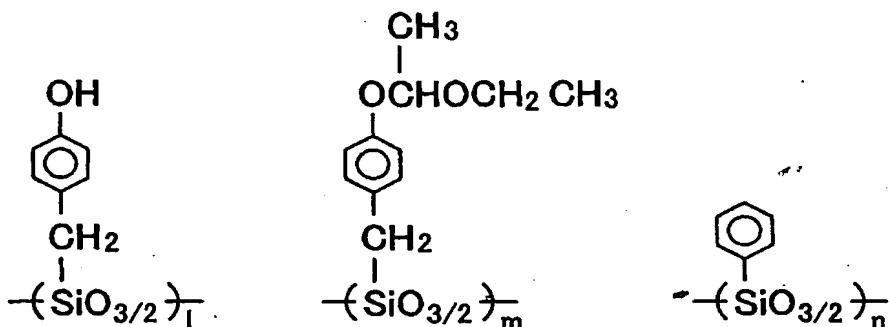
次に、得られた共重合体A₁50gを150m^lのアセトニトリルに溶解し、ここへトリメチルシリルヨード80g(0.40mol)を加え、還流下に24時間かきませたのち、水50m^lを加え、さらに12時間還流下でかきませて反応させた。冷却後、亜硫酸水素ナトリウム水溶液で遊離のヨウ素を還元したのち、有機層を分離し、溶媒を減圧下に留去し、次いで得られたポリマーをアセトンとn-ヘキサンで再沈し減圧加熱乾燥することで、p-ヒドロキシベンジルシリセスキオキサン70モル%と、ベンジルシリセスキオキサン30モル%とからなる共重合体A₂を得た。

【0093】

次いで、得られた共重合体A₂ 40 gをテトラヒドロフラン(THF) 200 mlに溶解し、これに酸性触媒としてp-トルエンスルホン酸一水和物を1.0 gと、エチルビニルエーテルを5.0 g添加し、23℃の条件で3時間程度反応させた。この後、反応液を水中に攪拌しながら注ぎ、ポリマーを析出させ、下記【化7】で表されるシルセスキオキサン樹脂(X1)を40 g得た。式中の1:m:n=50モル%:20モル%:30モル%であり質量平均分子量は7500である。分散度は約1.7であった。

【0094】

【化7】



【0095】

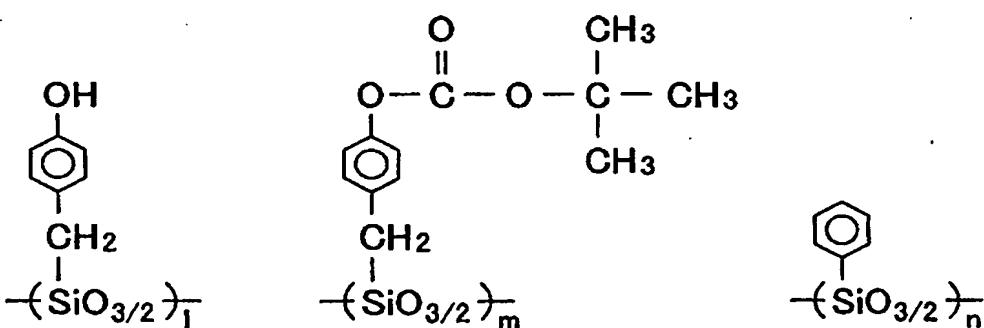
(シルセスキオキサン樹脂の合成例2)

上記合成例1におけるエチルビニルエーテルに代えてジ-tert-ブチルジカルボネートを用い触媒を塩基触媒のトリエチルアミンに変えた他は、上記合成例1と同様にして、下記化学式【化8】で表されるシルセスキオキサン樹脂(X2)を40 g得た。式中の1:m:n=50モル%:20モル%:30モル%であり、質量平均分子量は7500である。

分散度は約1.7であった。

【0096】

【化8】



【0097】

(実施例1)

前記合成例1で得たシルセスキオキサン樹脂(X1)100質量部を950質量部の乳酸エチルに溶解し、3質量部のトリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、2質量部のビス(シクロヘキシリズルホニル)ジアゾメタン及び0.25質量部のトリエタノールアミンを加えて、ポジ型レジスト組成物を調製した(Si含有量16.20%)。

【0098】

次に、シリコン基板上に、下部有機膜材料として、TBL-C-100(東京応化工業社製)をスピナーを用いて塗布し、230℃で90秒間ペーク処理して膜厚420 nmの下部有機層を形成した。

下部有機層上に、先に得られたポジ型レジスト組成物をスピナーナーを用いて塗布し、90°Cで90秒間ペーク処理し、乾燥することにより、膜厚150nmの上部レジスト層を形成し、レジスト積層体を形成した。

ついで、該上部レジスト層に対し、KrF露光装置NSR-S203B（ニコン社製；NA（開口数）=0.68, σ=0.75）により、KrFエキシマレーザー（248nm）を、ハーフトーン型（透過率6%、マスクバイアス40nm）のマスクパターンを介して選択的に照射した。

そして、100°C、90秒間の条件でPEB処理し、さらに23°Cにて2.38質量%テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド水溶液で60秒間現像処理することにより、口径160nmのコンタクトホール（CH）パターン（I）を得た。

このCHパターン（I）に対し、高真空RIE装置（東京応化工業社製）を用いて、酸素プラズマによるドライエッ칭を行い、下部有機層にCHパターン（II）を形成した。

【0099】

パターンの評価方法

また、得られたCHパターン（（I）と（II）の積層体、以下積層CHパターンという）のエッジラフネスと断面形状の矩形性を走査型電子顕微鏡（SEM）により観察して評価した。

本明細書ではエッジラフネスの評価結果については、滑らかな円の場合を○、若干歪のある円の場合を○、歪の激しい円の場合を×として示す。断面形状の評価結果については、垂直性の高い円筒断面形状の場合を○、垂直性はやや劣るが許容範囲の円筒断面形状の場合を○、円筒断面形状がくずれている場合を×として示す。

【0100】

本実施例で得られた積層CHパターンのエッジラフネスは○、断面形状は○であった。

また、本実施例において、口径160nmの積層CHパターンが良好な形状で得られる焦点深度幅は0.5μmで、十分であった。

さらに、口径160nmの積層CHパターンが±10%内の範囲で得られる露光余裕度は15.2%と良好であった。

【0101】

（実施例2）

前記合成例1と同様の手順で、上記【化7】で表されるシルセスキオキサン樹脂を調製した。ただし本実施例では、式中の1:m:n=65モル%:20モル%:15モル%とした。質量平均分子量は6500であった。

このシルセスキオキサン樹脂を用いた他は上記実施例1と同様にして、ポジ型レジスト組成物を調製し（Si含有量は16.20%）、レジスト積層体を形成し、CHパターン（I）およびCHパターン（II）からなる積層CHパターンを形成した。

本実施例で得られた積層CHパターンのエッジラフネスは○、断面形状は○であった。また、焦点深度幅は0.5μmで、露光余裕度は14.3%と良好であった。

【0102】

（実施例3）

前記合成例2で得たシルセスキオキサン樹脂（X2）100質量部を用いた他は上記実施例1と同様にして、ポジ型レジスト組成物を調製し、レジスト積層体を形成し、CHパターン（I）およびCHパターン（II）からなる積層CHパターンを形成した。

本実施例で得られた積層CHパターンのエッジラフネスは○、断面形状は○であった。また、焦点深度幅は0.5μmで、露光余裕度は10.9%と良好であった。

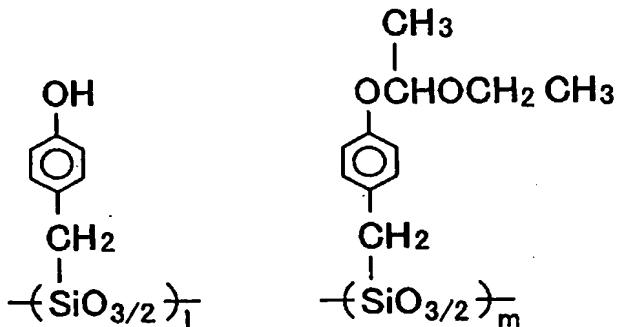
【0103】

（比較例1）

特開平9-87391の【0076】と【0077】に記載されている手順で、下記【化9】で表されるシルセスキオキサン樹脂を調製した。式中の1:m=80モル%:20モル%であり、質量平均分子量は5200であった。

【0104】

【化9】



【0105】

このシルセスキオキサン樹脂を用いた他は上記実施例1と同様にして、ポジ型レジスト組成物を調製し、レジスト積層体を形成し、CHパターン(I)およびCHパターン(I)からなる積層CHパターンを形成した。

本実施例で得られた積層CHパターンのエッジラフネスは×、断面形状は×であった。また、焦点深度幅は0.4 μmで、露光余裕度は10.8%であった。

【0106】

(実施例4)

シリコン基板上に、下部有機膜材料として、TBL C-100(商品名；東京応化工業社製)をスピナーを用いて塗布し、230°Cで90秒間ペーク処理して膜厚455nmの下部有機層を形成した。

下部有機層上に、実施例1のポジ型レジスト組成物をスピナーを用いて塗布し、90°Cで90秒間ペーク処理し、乾燥することにより、膜厚200nmの上部レジスト層を形成し、レジスト積層体を形成した。

ついで、該上部レジスト層に対し、Krf露光装置NSR-S203B(ニコン社製；NA(開口数)=0.68, σ=0.60)により、Krfエキシマレーザー(248nm)を、ハーフトーン型(透過率6%、マスクバイアス40nm)のマスクパターンを介して選択的に照射した。

そして、100°C、90秒間の条件でPEB処理し、さらに23°Cにて2.38質量%テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド水溶液で60秒間現像処理することにより、口径160nmのコンタクトホール(CH)パターン(I)を得た。次いで、100°Cで60秒間のポストペークを行った。

【0107】

このCHパターン(I)に対し、アクリル酸とビニルピロリドンのコポリマー(アクリル酸:ビニルピロリドン=2:1(質量比))10g、およびポリオキシエチレンのリン酸エステル系界面活性剤として「ブライサーフA210G」(第一工業製薬社製)0.1g、トリエタノールアミン0.9gを純水に溶解し、全体の固形分濃度を8.0質量%とした水溶性樹脂被覆を塗布して積層体とした。積層体の水溶性樹脂被覆の膜厚(基板表面からの高さ)は200nmであった。この積層体に対し、90°C、100°C、又は110°Cで60秒間加熱処理を行った。続いて23°Cで30秒間純水を用いてリーン処理して水溶性樹脂被覆を除去した。最後に100°Cで6.0秒間のポストペークを行った。

このようにして、口径160nmでピッチ320nmのコンタクトホール(CH)パターンが、狭小化されて口径130nmでピッチ320nmのコンタクトホール(CH)パターンが形成された。

そして、その狭小化された積層CHパターンのエッジラフネスは○、断面形状は○であった。

また、その焦点深度幅は0.40μmで、十分であった。

【0108】

(実施例5)

実施例1と同様にして、ポジ型レジスト組成物を調製した。

次に、磁性膜を設けたシリコン基板上に、下部レジスト材料として、TBL C-100 (商品名；東京応化工業社製) をスピナーを用いて塗布し、230℃で90秒間ベーク処理して膜厚2500nmの下部有機層を形成した。

下部有機層上に、先に得られたポジ型レジスト組成物をスピナーを用いて塗布し、ホットプレート上で95℃、90秒間ベーク処理し、乾燥することにより、膜厚300nmの上部レジスト層を形成し、レジスト積層体を形成した。

次に、該上部レジスト層に対し、KRF露光装置NSR-S203B (ニコン社製；NA (開口数) = 0.68, 2/3の輪帯照明) により、KRFエキシマレーザー (248nm) を、選択的に照射した。

そして、95℃、90秒間の条件でPEB処理し、23℃にてアルカリ現像液にて60秒間現像処理して、250nmのL&Sパターン(I)を得た。アルカリ現像液としては、2.38質量%テトラメチルアンモニウムハイドロキサイド(TMAH)水溶液を用いた。得られたL&Sパターン(I)は、断面形状が垂直であった。

このパターンに対し、高真空RIE装置(東京応化工業社製)を用いて、酸素プラズマによるドライエッティングを行い、下部有機層にレジストパターン(II)を形成した。

その結果、膜厚2500nmを有する250nmのラインという、微細かつ厚膜なL&Sパターンを得ることができた。

【0109】

まだ、パターン幅300nmのドットパターン(I)を形成したこと以外は、上記L&Sパターンの場合と同様に行った。その結果、得られたドットパターン(I)は断面形状が垂直であり、ドライエッティングを経て、膜厚2500nm、パターン幅300nmの、微細かつ厚膜なドットパターンを得ることができた。

【0110】

(実施例6)

(A) 成分として実施例1と同様のシルセスキオキサン樹脂を100質量部、(B) 成分としてビス-O-(n-ブチルスルホニル)- α -ジメチルグリオキシム8質量部、トリフェニルスルホニウムノナフルオロブタンスルホネート0.4質量部、(C) 成分としてトリオクチルアミン1.5質量部、(D) 成分としてサリチル酸1.2質量部、及び溶解抑制剤として下記式[化10]で示される化合物4質量部をプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート950質量部に均一に溶解してポジ型レジスト組成物を調製した(Si含有量16.2%)。

前記ポジ型レジスト組成物を、実施例5と同様の下部有機層(膜厚2500nm)を設けた磁性膜付の8インチシリコン基板上に塗布した。その後、90℃にて90秒ベーク処理し、乾燥することにより、膜厚300nmの上部レジスト層を形成した。

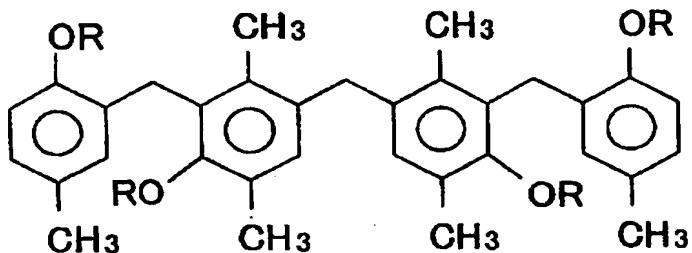
ついで、該上部レジスト層に対し、EB描画装置(日立ハイテクノロジー社製、HL-800D、加速電圧70kV)にて描画を行った。そして、100℃にて90秒間ベーク処理、TMAH 2.38%水溶液にて60秒現像、純水にて30秒リーンス、振り切り乾燥を行った後、100℃にて60秒ベーク処理を行った。この処理によって、150nmのL&Sパターン(I)、150nmのドットパターン(I)を得た。

これらのレジストパターン(I)に対し、実施例5と同様にドライエッティングを行い、下部有機層にレジストパターン(II)を形成した。

その結果、膜厚2500nmを有する150nm L&Sパターンおよび150nm ドットパターンという、微細かつ厚膜なレジストパターンを得ることができた。

【0111】

【化10】

(Rは-C₂H₅COO-tert-ブチル基である)

【0112】

(実施例7)

ポジ型レジスト組成物を、下部有機層を有さずヘキサメチルシラザン処理された8インチシリコン基板上に塗布した以外は、実施例6と同様に行ってレジスト膜を形成した。ついで、該レジスト膜に対し、実施例6と同様に描画、ペーク処理、現像、リノス、乾燥、ペーク処理を行って、150nmのL&Sパターンを得た。その際に、パターン倒れ、ランエッジラフネス等の問題は無かった。

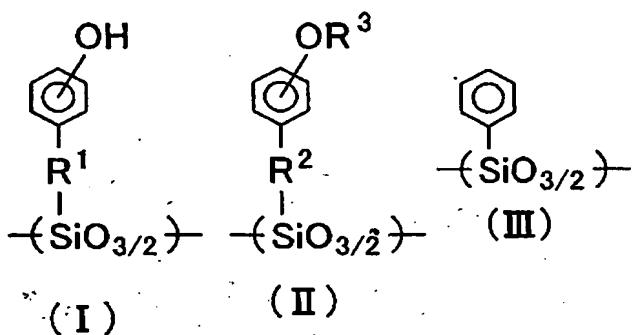
【書類名】要約書

【要約】

【課題】 シリコーン樹脂を用いた化学增幅型レジスト組成物であって、焦点深度や露光余裕度といったリソグラフィー特性やレジストパターンの形状特性に優れたポジ型レジスト組成物を提供する。

【解決手段】 酸の作用によりアルカリ可溶性が増大する樹脂成分（A）と、露光により酸を発生する酸発生剤成分（B）とを含むポジ型レジスト組成物であって、前記（A）成分が、（a 1）下記一般式（I）で表される構成単位、（a 2）下記一般式（I I）で表される構成単位、および（a 3）下記一般式（I I I）で表される構成単位（A 1）を有するシリセスキオキサン樹脂を含有してなるポジ型レジスト組成物。

【化1】



(式中、R¹は炭素数1～5の直鎖状または分岐状のアルキレン基を表し、R²は炭素数1～5の直鎖状または分岐状のアルキレン基を表し、R³は酸解離性溶解抑制基を表す。)

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2004-112511
受付番号	50400587313
書類名	特許願
担当官	新井 裕善 7660
作成日	平成 16 年 5 月 26 日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】	000220239
【住所又は居所】	神奈川県川崎市中原区中丸子 150 番地
【氏名又は名称】	東京応化工業株式会社
【代理人】	申請人
【識別番号】	100106909
【住所又は居所】	東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	棚井 澄雄

【代理人】

【識別番号】	100064908
【住所又は居所】	東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】	100094400
【住所又は居所】	東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	鈴木 三義

【選任した代理人】

【識別番号】	100106057
【住所又は居所】	東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	柳井 則子

【選任した代理人】

【識別番号】	100101465
【住所又は居所】	東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	青山 正和

特願2004-112511

ページ： 2/E

出証特2004-3050283

特願 2004-112511

出願人履歴情報

識別番号 [000220239]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住所 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地
氏名 東京応化工業株式会社